

智慧財產及商業法院行政判決

113年度行專訴字第61號

民國114年6月11日辯論終結

原告 林璟棠

訴訟代理人 陳豫宛專利師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 廖承威

訴訟代理人 林麗芬

參加人 李忱堅

訴訟代理人 陳軍宇律師

黃郁孟律師

輔佐人 李昇叡

上列當事人間新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國113年10月14日經法字第11317305340號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人參加訴訟，判決如下：

主 文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

甲、程序方面：

原告起訴聲明原為：「原處分及訴願決定關於『請求項1至7舉發成立』全部撤銷」；「被告就公告第M606835號新型專利（下稱系爭專利）舉發事件（109212330N01），應作成『請求項1至7舉發不成立』之處分」，嗣變更為「原處分及訴願決定均撤銷」（本院卷第13頁、第212頁），核其所為係使其聲明更明確，並非訴之變更追加，自應准許，合先敘明。

乙、實體方面：

壹、爭訟概要：

01 原告於民國109年9月18日以「晶圓載片清洗治具」向被告申
02 請新型專利，經編為第109212330號進行形式審查後准予專
03 利，並發給新型第M606835號專利證書（申請專利範圍共7
04 項）。嗣參加人以系爭專利有違核准時專利法第120條準用
05 第22條第1項第1款及第2項規定提起舉發。案經被告審認系
06 爭專利有違前揭專利法第120條準用第22條第2項規定，於11
07 3年5月10日以（113）智專議(三)05078字第11320481100號專
08 利舉發審定書為「請求項1至7舉發成立，應予撤銷」之處分
09 （下稱原處分）。原告不服提起訴願，經濟部於113年10月1
10 4日以經法字第11317305340號訴願決定書（下稱訴願決定）
11 予以駁回，原告不服提起本訴。本院認為本件判決結果將影
12 響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加
13 本件訴訟（本院卷第163至164頁）。

14 貳、原告主張及聲明：

15 一、證據2與證據3兩者裝置的用途及功能性上均不相同，因此證
16 據2及證據3之間欠缺技術領域上的關連性，無結合動機。證
17 據2用於晶圓載片（IC載板，或稱IC基板）於電路蝕刻、切割
18 後進行清洗之放置架，證據3晶片承載裝置，係裝載已封裝
19 完成之晶片，兩者在功能性不相同，技術領域無關。如果證
20 據2通過證據3設置傾斜面以增加的縱深，這只會增加承載件
21 122以周壁121為中心的槓桿距離，導致承載件122的結構更
22 容易破損，證據2及證據3在功能或作用上實欠缺共通性。證
23 據2的實用新型涉及一種晶圓清洗裝置，與證據3的晶片承載
24 裝置單純收納晶片的功能並不相同，證據3基本無法用於清
25 洗晶片亦或是證據2的晶圓載片，本領域通常知識者難以想
26 到將其與證據2的晶圓載片清洗治具相互結合。證據3在未分
27 離狀態時，空腔（如標號510處）係呈壓力平衡的狀態，晶片
28 仍然會因為震動而損壞。證據3晶片的上側空間顯然過於寬
29 裕，這使得證據3的晶片承載裝置在清洗過程中容易因為震
30 動而損壞晶片。依照證據2圖2承載件的設置位置，結合證據

01 3設置傾斜面520增加縱深的技術特徵，只會造成相鄰的承載
02 件122之間產生干涉，證據2、證據3並無結合動機。

03 二、系爭專利第[0021]段揭露「將晶圓載片20放入其中一放置架
04 10放置單元12的容置空間122中」，但依證據3第[0009]、[0
05 011]段揭露內容，證據3實際上容置晶片C的是承載空間52
06 1，將證據3的凹槽510比對至系爭專利之容置空間122不合
07 理。系爭專利以線接觸的形式支撐晶圓載片20，在清洗的過
08 程中晶圓載片20可以在受壓而產生震動擺盪的狀況下，其碰
09 撞可有效降低晶圓載片20表面的刮痕及殘水，相較於證據2
10 及證據3的組合具有無法預期的效果。

11 三、系爭專利請求項1相較於證據2及證據3的組合應具進步性，
12 系爭專利請求項2至7係直接或間接附屬於請求項1，在請求
13 項1相較於證據2、證據3具進步性的前提下，請求項2至7亦
14 具進步性。系爭專利請求項3至7相對於系爭專利與證據2、
15 證據3之組合，當也具進步性。

16 四、聲明如甲之變更後聲明所示。

17 參、被告答辯及聲明：

18 一、證據2雖未揭露系爭專利請求項1之「各該承載件具有一抵頂
19 面，該抵頂面為一斜面，且自位於該內框的上方位位置朝向該
20 容置空間的方向向下傾斜，其中，向下傾斜角度為以該抵頂
21 面的最高點與最低點之間連接之假想線與經過該抵頂面最高
22 點的假想水平線之間的夾角角度」技術特徵，然證據3說明
23 書第[0009]段、第[0011]段揭示內容可知，證據3之「傾斜
24 面520」、「第一凹槽510」，對應系爭專利請求項1之「抵
25 頂面」、「容置空間」，已揭露系爭專利請求項1前揭技術
26 特徵。證據2、3具有承載晶圓載片的治具，具有技術領域關
27 連性；具有放置晶圓載片，使在製程中運送之晶圓載片不會
28 發生碰撞、散亂而損壞晶片，具有功能或作用之共通性；依
29 證據2說明書第[0052]段、證據3說明書第[0009]段及圖4、6
30 內容，證據2已揭露以承載件接觸晶圓載片，證據3則教示並
31 建議承載件係以傾斜面的方式與晶圓載片接觸，故證據3已

01 教示或建議可與證據2結合，系爭專利所屬技術領域中具有
02 通常知識者有動機結合證據2、3而完成系爭專利請求項1之
03 前揭技術特徵。

04 二、證據2承載件122相當於系爭專利之承載件技術特徵，證據3
05 說明書第[0011]段揭示晶片C的外周緣會靠抵於該晶片承載
06 裝置3a之該等傾斜面520上，圖6揭示傾斜面520下緣對應凹
07 槽510之表面朝向承載空間521的方向向上傾斜，已揭露系爭
08 專利請求項2之技術特徵，證據2、3之組合可證明系爭專利
09 請求項2不具進步性。且系爭專利所屬技術領域中具有通常
10 知識者依證據2、3技術內容可預期於清洗過程中防止碰撞而
11 損壞晶片之功效。

12 三、證據2承載件122相當於系爭專利請求項2之承載件技術特
13 徵，依證據3說明書第[0009]段、第[0011]段及圖6揭示內
14 容，證據3限位單元5傾斜面520即相當系爭專利請求項2承載
15 件之抵頂面、底面技術特徵。系爭專利之放置架相互疊合，
16 晶圓載片片體表面與周緣接觸承載件抵頂面及底面斜面，與
17 證據3晶片承載裝置3，晶片C外周緣接觸傾斜面520、嵌合單
18 元6斜接面亦為向上傾斜。又依證據2說明書第[0045]段揭示
19 限位件13的外徑是由其上端向下逐漸遞增，第[0052]段揭示
20 各限位件13是外徑由上端向下逐漸遞增的柱體，已揭露系爭
21 專利請求項3附屬技術特徵。而依系爭專利說明書第[0017]
22 段記載「上限位件126及下限位件127的形狀可依使用者需求
23 作改變」，證據2已揭露系爭專利請求項3之附屬技術特徵前
24 提下，更可證明系爭專利請求項3之附屬技術特徵為系爭專
25 利所屬技術領域中具有通常知識者之簡單變更，可證明系爭
26 專利請求項3不具進步性。

27 四、聲明：駁回原告之訴。

28 肆、參加人陳述及聲明：

29 一、證據2說明書第[0045]段與圖8記載該承載件122包含一頂
30 面，該頂面朝上方且為凸面，證據2的承載件122(比對為系
31 爭專利的「承載件」)是平面、斜面，皆無損其承載之用

01 途。縱使認為證據2的承載件122為平面，但若調整為斜面，
02 依據證據2第[0057]段的記載，顯為利用證據2揭示的技術內
03 容所作出的些許更動或修飾，而為簡單修改，等同變化與修
04 飾的簡單變更，證據2已揭露系爭專利請求項1技術特徵，足
05 以證明系爭專利請求項1不具新穎性、進步性。

06 二、證據3說明書第[0011]段內容亦揭露系爭專利請求項1前述技
07 術特徵，證據2、證據3之國際專利分類號均為「H01L21」，
08 技術領域相同，可認屬同一技術領域，證據2之承載件122的
09 頂面與證據3之傾斜面520，皆為將對應物置入後，所靠抵之
10 處，證據2、證據3結合後，因晶圓載片將與所抵頂之元件呈
11 現「線接觸」，將具有「降低震盪造成晶圓載片表面刮痕」
12 之功效，具有結合動機，原告僅以貫孔具備與否之差異，而
13 認證據2、證據3無結合動機，刻意忽略兩者功能及作用之共
14 通性，應無可採。將證據2之「頂面」變更為證據3之「斜
15 面」，屬於本領域具有通常知識者依證據2、證據3所揭示之
16 技術，簡單組合變更而能輕易完成，足以證明系爭專利請求
17 項1不具進步性。

18 三、聲明：駁回原告之訴。

19 伍、爭點（本院卷第215頁）：

20 一、證據2是否足以證明系爭專利請求項1不具新穎性？

21 二、證據2、3之組合是否足以證明系爭專利請求項1至7不具進步
22 性？

23 三、證據1系爭專利說明書所載通常知識及證據2、3之組合是否
24 足以證明系爭專利請求項3至7不具進步性？

25 陸、本院判斷：

26 一、系爭專利之申請日為109年9月18日，於同年11月9日經形式
27 審查准予專利。參加人主張系爭專利違反核准時專利法第12
28 0條準用第22條第2項規定提起舉發，是以系爭專利有無撤銷
29 原因，應以核准時有效之108年7月31日修正公布，同年11月
30 1日施行之專利法為斷（下稱核准時專利法）。而依同法第1
31 20條準用第22條第2項規定，新型為其所屬技術領域中具有

通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，不得取得
新型專利。

二、系爭專利技術分析：

(一)系爭專利技術內容：

1.系爭專利所欲解決問題：

現有技術的晶圓載片其厚度最大為3mm，因此位於下方承載件的頂面至位於上方承載件的底面之間所預留的高度為3mm，當厚度小於3mm的晶圓載片放置於放置單元的容置空間時，其上方即會產生一閒置空間，當利用超音波或高壓空氣對晶圓載片進行清潔動作時，容易導致晶圓載片產生上下方向的震動，而又因為清洗治具的承載件其頂面為一平面，與晶圓載片為面接觸，當晶圓載片震動時，其貼靠於承載件的部分則會因為連續的敲擊摩擦而產生大面積的刮痕，導致成品的良率下降（系爭專利說明書第[0003]段，本院卷第221頁）。

2.系爭專利之技術手段：

有鑒於現有技術的缺點及不足，系爭專利提供一種晶圓載片清洗治具，其藉由將承載件的抵頂面設置為斜面，且自位於該內框的上方位位置朝向該容置空間的方向向下傾斜，達到在清洗的過程中降低晶圓載片與抵頂面因為碰撞而產生表面刮痕之目的（系爭專利說明書第[0004]、[0005]段，本院卷第222頁）。

3.系爭專利之功效：

藉由將承載件的抵頂面及底面皆設置為斜面，因此即便當清洗晶圓載片的過程中因為晶圓載片受壓而產生震動擺盪持續碰觸敲擊到承載件的抵頂面或斜面，相較於現有技術承載件以面接觸形式支撐晶圓載片，系爭專利以線接觸的形式支撐晶圓載片其碰撞可有效降低晶圓載片表面的刮痕，進而提升產品的品質，降低產品的不良率（系爭專利說明書第[0012]段，本院卷第223頁）。

01 (二)系爭專利申請專利範圍（主要圖式如附件圖1、圖2所
02 示）：

03 系爭專利申請專利範圍共7項，其中第1項為獨立項，其餘為
04 附屬項，內容如下（以下「請求項」如未註明，均指系爭專
05 利請求項內容）：

- 06 1.請求項1：一種晶圓載片清洗治具，其包含：二放置架，其
07 結構相同且能分離地相互疊合，各該放置架包含一外框及複
08 數放置單元，該外框為一環狀框體，該複數放置單元排列設
09 置在該外框內，各該放置單元包含一內框、複數承載件及複
10 數上限位件，該內框圍繞形成一容置空間，該複數承載件環
11 繞間隔凸設於該內框上且朝向該容置空間突伸，各該承載件
12 具有一抵頂面，該抵頂面為一斜面，且自位於該內框的上方
13 位置朝向該容置空間的方向向下傾斜，其中，向下傾斜角度
14 為以該抵頂面的最高點與最低點之間連接之假想線與經過該
15 抵頂面最高點的假想水平線之間的夾角角度，該複數上限位
16 件環繞間隔凸設於該內框的頂側面。
- 17 2.請求項2：如請求項1所述之晶圓載片清洗治具，其中各該承
18 載件進一步包含一底面，該底面為一斜面且朝向該容置空間
19 的方向向上傾斜。
- 20 3.請求項3：如請求項1或2所述之晶圓載片清洗治具，其中各
21 該上限位件為一錐狀體，其外徑朝向上方方向延伸逐漸減
22 少。
- 23 4.請求項4：如請求項3所述之晶圓載片清洗治具，其中各該放
24 置單元進一步包含複數下限位件，各該下限位件環繞間隔凸
25 設於該內框的底側面。
- 26 5.請求項5：如請求項4所述之晶圓載片清洗治具，其中該複數
27 下限位件為錐狀體，其外徑朝向下方向延伸逐漸減少。
- 28 6.請求項6：如請求項5所述之晶圓載片清洗治具，其中該抵頂
29 面的向下傾斜角度為20度。
- 30 7.請求項7：如請求項6所述之晶圓載片清洗治具，其中該底面
31 的向上傾斜角度為20度。

01 三、舉發證據說明：

02 (一)證據1為系爭專利說明書公告本。

03 (二)證據2為109年4月7日中國大陸公告第210272284號「具有防
04 呆裝置的晶圓載片清洗治具」實用新型專利案，其公告日早
05 於系爭專利申請日(109年9月18日)，可為系爭專利之先前技
06 術（主要圖式如附件圖3所示）。

07 (三)證據3為107年6月11日我國公告第M561912號「晶片承載裝
08 置」新型專利案，其公告日早於系爭專利申請日，可為系爭
09 專利之先前技術（主要圖式如附件圖4所示）。

10 四、爭點分析：

11 (一)證據2不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性：

12 1.證據2實用新型名稱為「具有防呆裝置的晶圓載片清洗治
13 具」，可對應系爭專利請求項1「一種晶圓載片清洗治具」
14 技術特徵（下以1A代稱）；證據2請求項1記載「包含：兩放
15 置架，該兩放置架係能分離地疊合，各放置架其包含一外環
16 壁及多個放置單元，該多個放置單元排列設在該外環壁內而
17 受該外環壁圍繞」，由證據2圖1可看出證據2之「外環壁」
18 為環狀框體，可對應請求項1之「外框」，故證據2請求項
19 1、圖1可對應系爭專利請求項1「其包含：二放置架，其結
20 構相同且能分離地相互疊合，各該放置架包含一外框及複數
21 放置單元，該外框為一環狀框體，該複數放置單元排列設置
22 在該外框內」技術特徵（下以1B代稱）；證據2請求項1記載
23 「各放置單元包含一周壁及該周壁圍成的一容置空間」、證
24 據2請求項9記載「各放置單元包含多個承載件，該多個承載
25 件不相連，各承載件設在該周壁、突入該容置空間且包含一
26 頂面」、證據2說明書第[0052]段記載「各放置單元12會被
27 該多個限位件13導入容置空間並受該多個承載件122支撐」，
28 比較證據2圖3(如附件圖5)與系爭專利圖3，可看出證
29 據2之「周壁121」對應系爭專利之「內框」，證據2之「承
30 載件122」對應系爭專利之「承載件」，證據2之「限位件1
31 3」對應系爭專利之「上限位件」，故證據2請求項1、9、說

明書第[0052]段、圖3可對應系爭專利請求項1「各該放置單元包含一內框、複數承載件及複數上限位件，該內框圍繞形成一容置空間，該複數承載件環繞間隔凸設於該內框上且朝向該容置空間突伸」技術特徵（下以1C代稱）；證據2請求項10記載「各限位件設在該周壁的頂面」，由證據2圖3可看出複數限位件13環繞間隔凸設於周壁121上，故證據2請求項10、圖3可對應系爭專利請求項1「該複數上限位件環繞間隔凸設於該內框的頂側面」技術特徵（下以1E代稱）。

2.證據2說明書第[0045]段與圖1至3、8揭示承載件122包含一頂面，該頂面朝向上方且為凸面，揭示系爭專利請求項1「各該承載件具有一抵頂面」技術特徵〔下以1D(1)代稱〕，由證據2圖9(如附件圖6)可知承載件122頂面雖為一凸面，但不具有自位於該內框的上方位位置朝向該容置空間的方向向下傾斜斜面之特徵，證據2並未揭示系爭專利請求項1「該抵頂面為一斜面，且自位於該內框的上方位位置朝向該容置空間的方向向下傾斜，其中，向下傾斜角度為以該抵頂面的最高點與最低點之間連接之假想線與經過該抵頂面最高點的假想水平線之間的夾角角度」技術特徵〔下以1D(2)代稱〕，證據2不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性。

3.參加人稱證據2已揭露系爭專利請求項1技術特徵，足以證明系爭專利請求項1不具新穎性（理由如前肆之一所述，本院卷第109至110頁、第265頁、第313頁）。惟系爭專利說明書第[0016]段記載「承載件123為一自內框121朝向容置空間122突伸之塊體，其具有一抵頂面124及一底面125，抵頂面124為一斜面，抵頂面124自位於內框121上方位位置朝向容置空間122的方向向下傾斜」；第[0021]段記載「各晶圓載片20會被上限位件126導入容置空間122直至晶圓載片20的下緣貼靠於承載件123的抵頂面124而停止，此時承載件123與晶圓載片20之間是以線接觸的方式貼靠達到承載之目的」，再參諸系爭專利圖3、4(如附件圖7、圖2)，可知系爭專利承載件之頂面雖為凸面，但自頂面向下傾斜之抵頂面為直線的斜面

(如附件圖2所示)，且承載件與晶圓載片下緣接觸的部位為抵頂面而非承載件頂面或其他非抵頂面的部位(如附件圖7橘線所示)。然證據2說明書第[0045]段記載「各承載件122突入該容置空間，且該承載件122包含一頂面，該頂面朝向上方且為凸面」；第[0052]段記載「請參看圖8及圖9……各放置單元12會被該多個限位件13導入容置空間並受該多個承載件122支撐」，再參諸證據2圖8、9，可看出承載件122頂面為凸面，晶圓載片下緣係與承載件頂面接觸(如附件圖6所示)，故參加人所提附表2-1第1頁(本院卷第109頁)所繪之承載件頂面之圓弧側邊(紅圈)(如附件圖8所示)並無法比對至系爭專利請求項1之抵頂面；參加人認為承載件由平面調整為斜面，為簡單變更，惟證據2與系爭專利之載片與承載件接觸面不同，兩者降低碰撞刮痕的效果也不相同，證據2無具體教示或建議如何變更載片與承載件之接觸面，無法由證據2晶圓載片底面與承載件抵頂面之面接觸方式，改變為晶圓載片底面、側面之轉角與承載件抵頂面之線接觸方式，其差異並非所屬技術領域中具有通常知識者經由簡單變更所能輕易完成，參加人所述並不足採。

4.就此爭點，原處分於舉發階段認證據2不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性，原告提起訴願及本件行政訴訟，並未表示不服，應非本件審理範圍，惟本院經當事人同意列入此爭點，當事人就此爭點已為言詞辯論，故仍予審酌如上，併此敘明。

(二)證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項1至7不具進步性：

1.系爭專利請求項1部分：

(1)證據2揭露系爭專利請求項1技術特徵1A至1C、1E已如前述，證據3說明書第[0009]段記載「四個環狀相間隔地凸設於該第一圍繞壁51上且各自形成一傾斜面520的限位壁52……」。該等傾斜面520相配合界定出一連通該第一凹槽510的承載空間521」；第[0011]段記載「該晶片C的外周緣會靠抵於該晶片承載裝置3a之該等傾斜面520上」，再參諸證據3圖4、6，

01 可看出證據3揭露之限位壁52具有一傾斜面520，由第一圍繞
02 壁51的上方位位置向第一凹槽510的方向向下傾斜，其中傾斜
03 面520高點與最低點之間連接之假想線與傾斜面最高點的假
04 想水平線之間具有一傾斜角度(如附件圖9所示)，當晶片C置
05 放於第一凹槽510時，晶片C的外周緣會靠抵於傾斜面520上
06 形成線接觸(如附件圖10所示)。因此證據3之「傾斜面520」
07 對應系爭專利之「抵頂面」，證據3之「承載空間521」對應
08 系爭專利之「容置空間」，故證據3說明書第[0009]、[001
09 1]段、圖4、6可對應系爭專利請求項1之1D(1)、1D(2) (即1
10 D) 技術特徵。

11 (2)證據2、3皆為製造過程中用於元件承載裝置之技術領域，參
12 以國際專利分類號IPC同屬H01L21，證據2揭露以限位件導入
13 容置空間並以承載件接觸晶圓載片，證據3則教示並建議承
14 載件係以傾斜面的方式與晶片接觸，故證據2、3具有相同導
15 入與承載電子元件之功能共通性，綜合考量證據2、3具有技
16 術領域關連性和功能共通性，該所屬技術領域中具有通常知
17 識者自有動機結合證據2、3揭露之技術內容，將證據3之傾
18 斜面結構應用於證據2之承載件上，完成系爭專利請求項1之
19 1D(1)、1D(2) (即1D) 技術特徵。證據2已揭示系爭專利請求
20 項1技術特徵1A至1C、1E，證據2、3之組合已揭示系爭專利
21 請求項1技術特徵1D，且證據2、3具有結合動機，證據2及證
22 據3之組合已揭示系爭專利請求項1技術特徵1A至1E，證據2
23 及證據3之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

24 2.系爭專利請求項2部分：

25 系爭專利請求項2依附於請求項1，其所界定之附屬技術特徵
26 如前所述，又證據2及證據3之組合足以證明系爭專利請求項
27 1不具進步性之理由已如前述。經查，證據3圖6已揭露由晶
28 片承載裝置3a、3b相疊，中間形成容置晶片之空間，該晶片
29 承載裝置3b下方內側輪廓具有一由外側往中心之向上傾斜角
30 度，由上可知，晶片上下晃動時，與證據3說明書第[0011]
31 段原理相同，晶片上方與晶片承載裝置3b下方內側之傾斜面

01 仍為線接觸，證據3已揭露系爭專利請求項2之附屬技術特
02 徵，故證據2及證據3之組合足以證明系爭專利請求項2不具
03 進步性。

04 3.系爭專利請求項3部分：

05 系爭專利請求項3依附於請求項1或2，其所界定之附屬技術
06 特徵如前所述，又證據2及證據3之組合足以證明系爭專利請
07 求項1、2不具進步性之理由已如前述。查證據2說明書第[00
08 45]段記載「該限位件13的外徑是由其上端向下逐漸遞
09 增」；第[0052]段記載「各限位件13是外徑由上端向下逐漸
10 遞增的柱體」，再參諸證據2圖3、8（如附件圖5、8），可
11 看出證據2之限位件13為一錐狀體，其外徑朝向上方方向延
12 伸而逐漸減少，證據2已揭露系爭專利請求項3之附屬技術特
13 徵，故證據2及證據3之組合足以證明系爭專利請求項3不具
14 進步性。

15 4.系爭專利請求項4、請求項5部分：

16 系爭專利請求項4依附於請求項3，請求項5依附於請求項4，
17 所界定之附屬技術特徵均如前述，又證據2及證據3之組合足
18 以證明系爭專利請求項3不具進步性之理由已如前述。查證
19 據2圖6係清洗治具放置架的背面仰視圖，由證據2圖6、9可
20 看出其揭露之清洗治具具有複數下限位件，且下限位件環繞
21 間隔凸設於該內框的底側面（如附件圖11、圖6所示），其
22 中，下限位件為錐狀體，其外徑朝向下方向延伸逐漸減
23 少，證據2已揭露系爭專利請求項4及請求項5之附屬技術特
24 徵，故證據2及證據3之組合足以證明系爭專利請求項4、5不
25 具進步性。

26 5.系爭專利請求項6、7部分：

27 系爭專利請求項6依附於請求項5，系爭專利請求項7依附於
28 請求項6，所界定之附屬技術特徵均如前述，又證據2及證據
29 3之組合足以證明系爭專利請求項5不具進步性之理由已如前
30 述。查證據3說明書第[0009]、[0011]段及圖4、6已揭露與
31 晶圓載片接觸之傾斜面高點與最低點之間連接之假想線與傾

01 斜面最高點的假想水平線之間具有一傾斜角度。證據3圖6已
02 揭露由晶片承載裝置3a、3b相疊，中間形成容置晶片之空
03 間，該晶片承載裝置3b下方內側輪廓具有一由外側往中心之
04 向上傾斜角度，因證據3已揭示晶片C外周緣會抵靠晶片承載
05 裝置3a之該等傾斜面520上，通常知識者由證據3教示可得知
06 當承載裝置3a、3b上下顛倒或傾倒時，晶片C外周緣仍以面
07 接觸方式接觸晶片承載裝置3a下方內側之傾斜面520。因系
08 爭專利說明書中並無說明傾斜角度設定為20度有產生任何特
09 殊功效或與其他角度相比有何特殊之處，故證據3雖未揭露
10 該傾斜角度數值，然該技術領域中具有通常知識者經由模擬
11 設計調整傾斜規格而無須過度實驗，即可輕易得知傾斜角度
12 可設為20度，證據2及證據3之組合足以證明系爭專利請求項
13 6、7不具進步性。

14 (三)證據1系爭專利說明書所載通常知識及證據2、3之組合足以
15 證明系爭專利請求項3至7不具進步性：

16 證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項3至7不具進步性已
17 如前述，是以，證據1系爭專利說明書所載通常知識及證據
18 2、3之組合亦足以證明系爭專利請求項3至7不具進步性。

19 (四)原告主張不可採之理由：

20 1.原告稱證據2與證據3並無結合動機（理由如前貳之一所述，
21 本院卷第14至17頁、第247至250頁、第295至298頁）。經
22 查，證據2、證據3皆為製造過程中用於承載電子元件裝置，
23 參以國際專利分類號均為H01L21(2006.01)主目下，堪認證
24 據2、證據3具有技術領域之關連性；證據2、3皆具有放置電
25 子元件使得在製程中運送時使電子元件不會碰撞、散亂而損
26 壞，具有功能或作用之共通性；證據2說明書第[0052]段記
27 載「將初步加工後的多個該晶圓載片80放入該放置單元12的
28 容置空間時，……，各放置單元12會被該多個限位件13導入
29 容置空間並受該多個承載件122支撐」、證據3說明書第[001
30 1]段記載「將該晶片C置於該晶片承載裝置3a之承載空間521
31 內，前述的置入過程中，該晶片C的外周緣會靠抵於該晶片

01 承載裝置3a之該等傾斜面520上」，證據2已揭露以承載件接
02 觸晶圓載片，證據3則教示並建議承載件係以傾斜面的方式
03 與晶圓接觸，故證據3已教示或建議可與證據2結合。綜合考
04 量證據2、3間技術內容的關連性和共通性，該技術領域中具
05 有通常知識者自有動機以結合證據2、3揭露之技術內容，將
06 證據3之傾斜面結構應用於證據2之承載件上，只會改變證據
07 2承載件頂面向容置空間的方向向下傾斜，並不會改變證據2
08 承載件122以周壁121為中心的槓桿距離，從而能完成系爭專
09 利請求項1技術特徵1D。另外，原告稱證據3晶片承載裝置上
10 下疊置時呈壓力平衡狀態，且晶片上下空間過於寬裕，容易
11 因震動而損壞晶片，惟證據3揭示晶片外周緣靠抵於晶片承
12 載裝置之該等傾斜面上，將證據3接觸方式用於證據2承載件
13 上，在證據2、3之結合下並無容置空間過於寬裕之問題，也
14 不會產生相鄰承載件有互相干涉的情況，原告主張不可採。

15 2.原告稱強行結合證據2與證據3也無法完成系爭專利請求項1
16 所請之創作，證據3承載空間過大只會導致晶片C碰撞，傾斜
17 面520的導正定位僅是為了將晶片C導正至正確位置，證據3
18 顯然並不能實現抗碰撞之目的，也未公開通過傾斜面520達
19 到在清洗過程中防止碰撞，而降低產生表面刮痕之效果，系
20 爭專利在清洗過程中，有效降低晶圓載片20表面的刮痕及殘
21 水，系爭專利請求項1相較於證據2及證據3之組合具有無法
22 預期的效果等情（本院卷第17至18頁）。經查，由原處分關
23 於系爭專利請求項1與證據組合比對，證據2為主要證據，而
24 證據3主要對應技術特徵1D部分，原處分用於比對系爭專利
25 容置空間之證據3第一凹槽510對應證據2放置單元之容置空
26 間，在結合證據2、3的情況下，係以證據3傾斜面與接觸晶
27 片外周緣之線接觸，取代證據2承載件接觸晶片底部之面接
28 觸，達成在清洗過程中避免承載件刮傷晶圓載片之功效，系
29 爭專利相較於證據2及證據3之組合並不具有無法預期之功
30 效，原告所訴不可採。

- 01 3.原告稱證據3的傾斜面520及傾斜面520下緣之表面朝向凹槽5
02 10方向的傾斜方向都是向下傾斜，並不會得到「該底面為一
03 斜面且朝向該容置空間的方向向上傾斜」的結果等情（本院
04 卷第19至22頁）。查原處分針對系爭專利請求項2比對理由
05 雖不明確，惟被告已說明請求項2之附屬技術特徵與證據3晶
06 片C外周緣接觸嵌合單元6斜接面之比對，兩者結構之作用或
07 功能結構相同，證據3嵌合單元6斜接面亦為向上傾斜，是以
08 原告主張不足採。
- 09 4.原告稱被告對系爭專利說明書內容超譯。系爭專利說明書第
10 [0017]段為系爭專利說明書的實施方式，並非先前技術，且
11 該等說明旨在於解釋並擴充系爭專利的保護範圍，並未述及
12 該等技術特徵為通常知識等情（本院卷第22至23頁）。經
13 查，系爭專利說明書第[0017]段為系爭專利說明書關於上限
14 位件與下限位件之說明，並非說明書第[0002]、[0003]段先
15 前技術，被告以系爭專利說明書第[0017]段為先前技術，應
16 有誤解，惟原處分此部分判斷不影響系爭專利請求項1至7舉
17 發成立，應予撤銷之結果。
- 18 5.原告稱系爭專利請求項1至3未有違反核准時專利法第120條
19 準用第22條第2項規定的情事，由於請求項4至7為請求項3的
20 附屬項，在請求項1至3未違反核准時專利法第120條準用第2
21 2條第2項有關進步性規定的情況下，系爭專利請求項4至7應
22 具有進步性等情（本院卷第23至24頁）。惟證據2、3之組合
23 足以證明系爭專利請求項1至3不具進步性，請求項4至7係直
24 接或間接依附於請求項1至3，證據2已揭露系爭專利請求項
25 4、請求項5之附屬技術特徵，證據3已揭露晶片外周緣靠抵
26 晶片承載裝置之該等傾斜面，該技術領域中具有通常知識者
27 自能由實際生產需求而無須過度實驗即可輕易得知傾斜角度
28 可設為20度，而完成請求項6、7之附屬技術特徵，證據2、3
29 具有結合動機，證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項4
30 至7不具進步性，原告主張不足採。

01 柒、綜上所述，系爭專利請求項1至7違反核准時專利法第120條
02 準用第22條第2項規定，原處分所為「請求項1至7舉發成
03 立，應予撤銷」之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦
04 無不合。從而，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理
05 由，應予駁回。

06 捌、本件判決基礎已經明確，當事人其餘攻擊防禦方法及訴訟資
07 料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，並無逐一論述必
08 要。

09 玖、結論：原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2條，
10 行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

11 中 華 民 國 114 年 7 月 23 日

12 智慧財產第一庭

13 審判長法 官 汪漢卿

14 法 官 蔡惠如

15 法 官 陳端宜

16 以上正本係照原本作成。

17 一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表
18 明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內
19 向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提
20 起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按
21 他造人數附繕本）。

22 二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，
23 逕以裁定駁回。

24 三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟
25 法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不
26 委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。
27

得不委任律師 為訴訟代理人 之情形	所 需 要 件
(一)符合右列情 形之一者，	1. 上訴人或其代表人、管理人、法定代 理人具備法官、檢察官、律師資格或

得不委任律師為訴訟代理人	為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2. 稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二) 非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

02 中 華 民 國 114 年 7 月 23 日
03 書記官 吳祉瑩